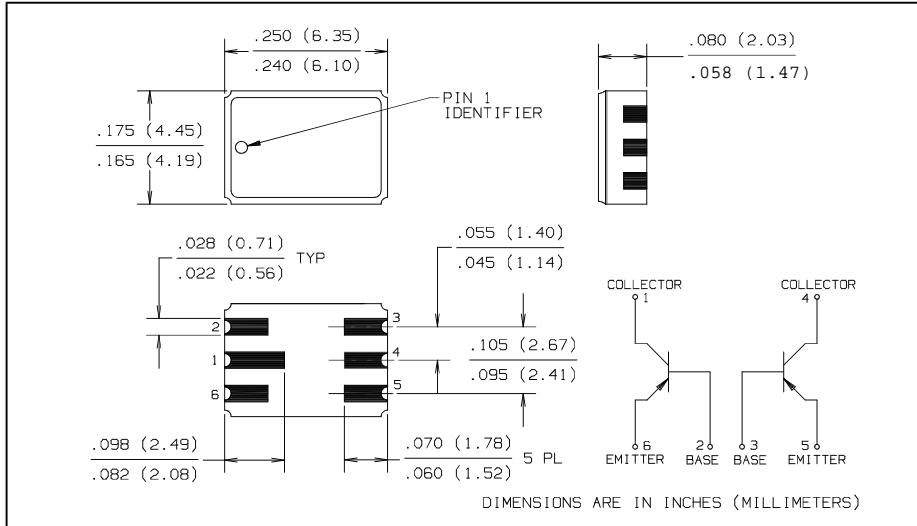


Surface Mount Dual PNP Transistor Type JANTX, JANTXV, 2N5796U



Features

- Ceramic surface mount package
- Hermetically sealed
- Miniature package minimizes circuit board area required
- Electrical performance similar to dual 2N2907A
- Qualification per MIL-PRF-19500/496

Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

Collector-Emitter Voltage	60 V
Collector-Base Voltage	60 V
Emitter-Base Voltage	5 V
Collector Current Continuous	600 mA
Operating and Storage (T_J, T_{stg})	-65° C to +200° C
Power Dissipation (single transistor, no heat sink)	0.5 W
Power Dissipation (total device)	0.6 W

Description

The JANTX2N5796U is a hermetically sealed, ceramic surface-mount device, consisting of two individual silicon PNP transistors. The six pin ceramic package is ideal for designs where board space and device weight are important design considerations.

Typical screening and lot acceptance tests are provided on page 13-4. The burn-in condition is $V_{CB} = 30$ V, $P_D = 300$ mW each transistor, $T_A = 25^\circ C$. Refer to MIL-PRF-19500/496 for complete requirements.

When ordering parts without processing, do not use a JAN prefix.

Type JANTX, JANTXV, 2N5796U

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

SYMBOL	PARAMETER	MIN	MAX	UNIT	TEST CONDITIONS
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	75		V	$I_C = 10 \mu A$
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	60		V	$I_C = 10 mA^{(1)}$
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage	5		V	$I_E = 10 \mu A$
I_{CBO1}	Collector-Base Cutoff Current		10	nA	$V_{CB} = 50 V$
I_{CBO2}	Collector-Base Cutoff Current		10	μA	$V_{BC} = 50 V, T_A = 150^\circ C$
I_{EBO}	Emitter-Base Cutoff Current		100	nA	$V_{EB} = 3 V$
h_{FE1}	Forward Current Transfer Ratio	75			$V_{CE} = 10 V, I_C = 100 \mu A$
h_{FE2}	Forward Current Transfer Ratio	100			$V_{CE} = 10 V, I_C = 1.0 mA$
h_{FE3}	Forward Current Transfer Ratio	100			$V_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA^{(1)}$
h_{FE4}	Forward Current Transfer Ratio	100	300		$V_{CE} = 10 V, I_C = 150 mA^{(1)}$
h_{FE7}	Forward Current Transfer Ratio	40			$V_{CE} = 10 V, I_C = 150 mA, T_A = -55^\circ C^{(1)}$
h_{FE5}	Forward Current Transfer Ratio	50			$V_{CE} = 10 V, I_C = 300 mA^{(1)}$
h_{FE6}	Forward Current Transfer Ratio	50			$V_{CE} = 1.0 V, I_C = 150 mA^{(1)}$
$V_{CE(SAT)1}$	Collector-Emitter Saturation Voltage		0.4	V	$I_C = 150 mA, I_B = 15 mA^{(1)}$
$V_{CE(SAT)2}$	Collector-Emitter Saturation Voltage		1.6	V	$I_C = 500 mA, I_B = 50 mA^{(1)}$
$V_{BE(SAT)1}$	Base-Emitter Saturation Voltage		1.3	V	$I_C = 150 mA, I_B = 15 mA^{(1)}$
$V_{BE(SAT)2}$	Base-Emitter Saturation Voltage		2.6	V	$I_C = 500 mA, I_B = 50 mA^{(1)}$
$ h_{fe} $	Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio	2	10		$V_{CE} = 20 V, I_C = 20 mA, f = 100 MHz$
C_{obo}	Open Circuit Output Capacitance		8	pF	$V_{CB} = 10 V, I_E = 0, 100 kHz \leq f \leq 1 MHz$
C_{ibo}	Input Capacitance		25	pF	$V_{EB} = 2.0 V, I_E = 0, 100 kHz \leq f \leq 1 MHz$
t_{on}	Turn-On Time		50	ns	$V_{CC} = 30 V, I_C = 150 mA, I_{B1} = 15 mA$
t_{off}	Turn-Off Time		140	ns	$V_{CC} = 30 V, I_C = 150 mA, I_{B1} = I_{B2} = 15 mA, PW = 200 ns$

HI-REL
SURFACE
MOUNT

(1) Pulsed Test: Pulse Width = 300 $\mu s \pm 50$, 1-2 % Duty Cycle.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331